

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
28. April 2005 (28.04.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/038930 A3**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 29/786**, 21/336, B81C 1/00, H01L 21/308

(74) Anwälte: **KINDERMANN**, Peter usw.; Patentanwälte Kindermann, Postfach 1330, 85627 Grasbrunn (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2004/052333**

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22) Internationales Anmeldedatum: 28. September 2004 (28.09.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10348007.2 15. Oktober 2003 (15.10.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **INFINEON TECHNOLOGIES AG** [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **TEWS, Helmut** [DE/DE]; Frankenwaldstr. 36, 81549 München (DE). **FEHLHABER, Rodger** [DE/DE]; Lautensackstr. 24, 80687 München (DE).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

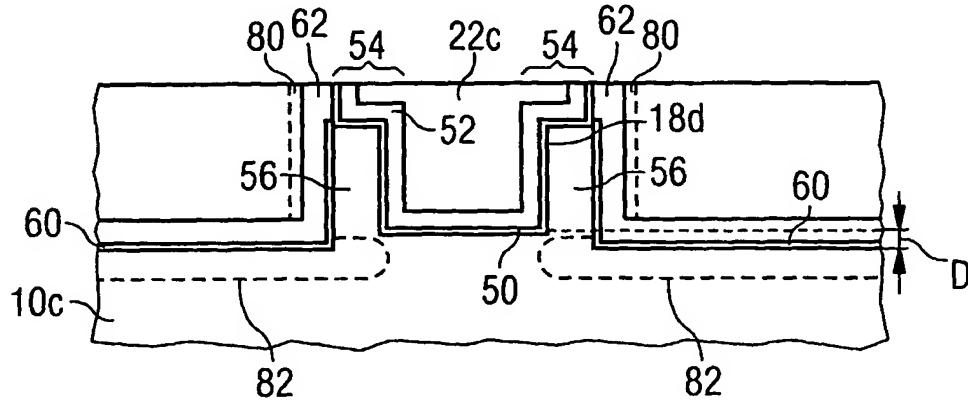
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: STRUCTURING METHOD, AND FIELD EFFECT TRANSISTORS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM STRUKTURIEREN UND FELDEFFEKTTRANSISTOREN



(57) Abstract: Disclosed is a structuring method, among other things. According to said method, a filling material (22) having a T-shaped cross section is used as a structuring mask in order to create structures with sublithographic dimensions, particularly a double-fin field effect transistor.

(57) Zusammenfassung: Erläutert wird unter anderem ein Verfahren zum Strukturieren, bei dem ein Füllmaterial (22) mit T-förmigem Querschnitt als Maske beim Strukturieren verwendet wird, um Strukturen mit sublithografischen Abmessungen zu erzeugen, insbesondere einen Doppel-Finnen-Feldeffekttransistor.

**WO 2005/038930 A3**



(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen  
Recherchenberichts: 9. Juni 2005

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*